

D1	D2	D3	D4	D5	Totale
/3	/5	/4	/3	/5	

D

$V_{DD} = 1V$

$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 0,25V$

$\beta'_n = 200 \mu A/V^2$

$\beta'_p = 100 \mu A/V^2$

$L_{min} = 0,09 \mu m$

$C_{ox} = 23 fF/\mu m^2$

$\lambda = \gamma = 0$

Si consideri inizialmente la linea di interconnessione L_1 ideale (cortocircuito).

- Si disegnano le reti di Pull Up e Pull Down del circuito FCMOS del primo stadio tale che:

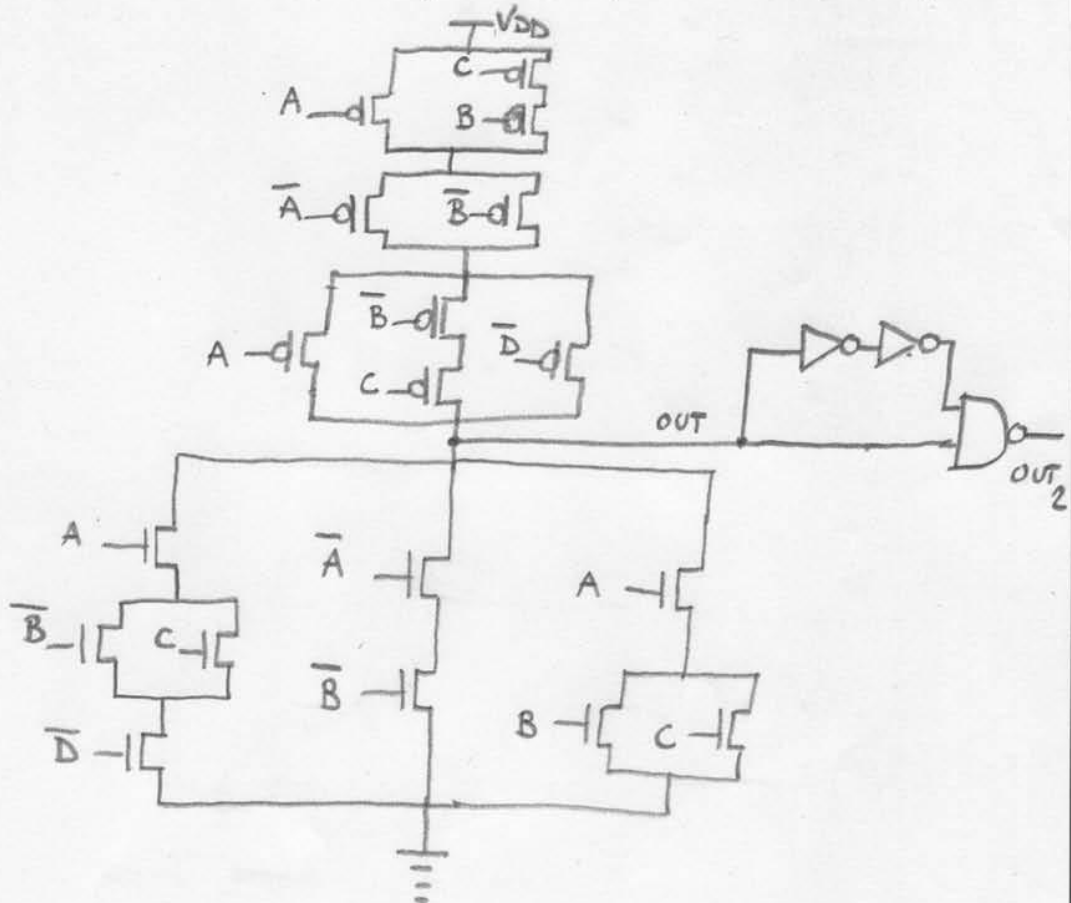
$$OUT_2 = A \cdot (\bar{B} + C) \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot (B + C)$$
- Dimensionare il fattore di forma dei transistori delle reti di Pull Up e Pull Down (S_N e S_P) in modo che, nel caso peggiore, i transistori al 90% al nodo OUT abbiano durata non superiore a 95 ps.
- Determinare il valore massimo della capacità di ingresso (specificando il segnale per cui si ottiene tale valore) nei seguenti casi: (a) il segnale negato è generato in modo indipendente dal segnale vero, (b) il segnale negato è generato a partire dal segnale vero con un inverter (i cui transistori hanno fattore di forma identico a quello degli inverter a valle del nodo OUT).

Si consideri ora la linea di interconnessione L_1 descritta mediante un modello elettrico a π e si indichi con $r = 0,25 \Omega/\mu m$ e $c = 0,02 fF/\mu m$ rispettivamente la resistenza e la capacità della linea di interconnessione per unità di lunghezza. Siano inoltre $R_{N,RIF,90\%,S=1,VGS=|VDD|} = 9567 \Omega$ e $R_{P,RIF,90\%,S=1,VGS=|VDD|} = 19134 \Omega$ le resistenze equivalenti relative a transistori NMOS e PMOS con fattore di forma unitario (per il calcolo dei transistori al 90%).

- Si consideri la transizione degli ingressi (A, B, C, D): $(0, 0, 1, 1) \rightarrow (0, 1, 1, 1)$. Si disegni il circuito RC equivalente per il calcolo della costante di Elmore.
- Si calcoli la durata dei transistori (al 90%) ai due ingressi del gate NAND a seguito della transizione degli ingressi definita al punto 4.

$$1) \text{ OUT}_2 = \overline{\text{OUT} \cdot \text{OUT}} = \overline{\text{OUT}}$$

$$\text{OUT} = A \cdot (\overline{B} + C) \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot (B + C)$$



2)

$$C_{OUT} = C_{OX} L_{min}^2 (S_{M_{INV}} + S_{P_{INV}}) + C_{OX} L_{min}^2 (S_{M_{NAND}} + S_{P_{NAND}}) =$$

$$= 23 \cdot 10^{-15} \cdot 8,1 \cdot 10^{-3} \cdot (12 + 24 + 8 + 16) =$$

$$= 11,178 \text{ fF}$$

CASO PEGGIORE PD 3 NMOS IN SERIE

$$A=1 \quad B=0 \quad C=0 \quad D=0$$

$$S_{PD} = S_m/3$$

$$t_{f,90\%} = \frac{2 C_{OUT}}{\beta'_m S_{PD}} F_{m90\%} = \frac{6 C_{OUT}}{\beta'_m S_m} F_{m90\%} \leq t^* = 95 \text{ ps}$$

$$S_m \geq \frac{6 C_{OUT}}{\beta'_m t^*} F_{m90\%} = \frac{6 \cdot 11,178 \cdot 10^{-15}}{200 \cdot 10^{-6} \cdot 95 \cdot 10^{-12}} \cdot 2,203 = 7,77$$

$$S_m \approx 8$$

CASO PEGGIORE PU 4 PMOS IN SERIE

$$A=1 \quad B=0 \quad C=0 \quad D=1$$

$$S_{PU} = S_p/4$$

$$t_{r90\%} = \frac{2 C_{OUT}}{\beta'_p S_{PU}} F_{p90\%} = \frac{8 C_{OUT}}{\beta'_p S_p} F_{p90\%} \leq t^* = 95 \text{ ps}$$

$$S_p \geq \frac{8 \cdot C_{OUT}}{\beta'_p t^*} \cdot F_{p90\%} = \frac{8 \cdot 11,178 \cdot 10^{-15}}{100 \cdot 10^{-6} \cdot 95 \cdot 10^{-12}} \cdot 2,203 = 20,73$$

$$S_p \approx 21$$

3)

(a) CASO PEGGIORE PER A , \bar{B} e C

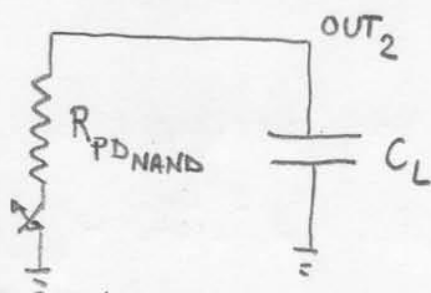
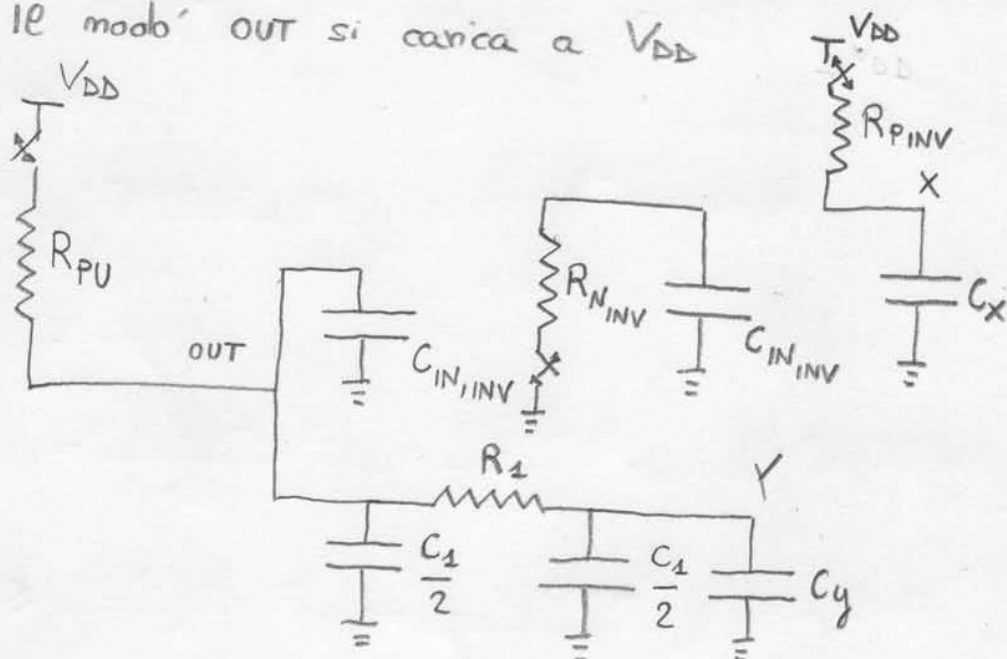
$$C_{im_{max}} = C_{ox} L_{min}^2 \cdot (2S_m + 2S_p) = 23 \cdot 10^{-15} \cdot 8,1 \cdot 10^{-3} \cdot (16 + 42) \\ = 10,8 \text{ fF}$$

(b) CASO PEGGIORE PER A

$$C_{im_MAX} = C_{ox} L_{min}^2 (2S_m + 2S_p) + C_{ox} L_{min}^2 (S_{m_INV} + S_{p_INV})$$

$$= 23 \cdot 10^{-15} \cdot 8,1 \cdot 10^{-3} (16 + 42 + 12 + 24) = 17,51 \text{ fF}$$

4) Sia $(A, B, C, D) : (0, 0, 1, 1) \longrightarrow (0, 1, 1, 1)$
 IE modo' OUT si carica a V_{DD}



5)

$$\Sigma_{IN,X} = \Sigma_{IN,OUT} + \Sigma_{I,INV} + \Sigma_{II,INV} = R_{PU} \cdot (C_{IN,INV} + C_1 + C_Y) + R_{N,INV} \cdot C_{IN,INV} + R_{P,INV} \cdot C_X$$

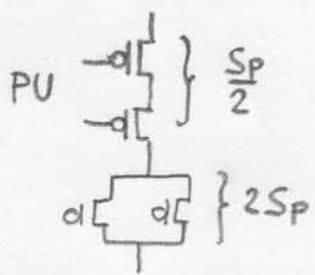
$$\Sigma_{IN,Y} = R_{PU} \cdot (C_{IN,INV} + C_1 + C_Y) + R_1 \left(\frac{C_1}{2} + C_Y \right)$$

Si ha $R_1 = r \cdot L_1 = 250 \Omega$ $C_1 = c \cdot L_1 = 20 \text{ fF}$

$$C_{IN,INV} = C_{OX} L_{min}^2 (S_{M,INV} + S_{P,INV}) = 23 \cdot 10^{-15} \cdot 8,1 \cdot 10^{-3} \cdot 36 = 6,706 \text{ fF}$$

$$C_X = C_Y = C_{OX} L_{min}^2 (S_{M,NAND} + S_{P,NAND}) = 23 \cdot 10^{-15} \cdot 8,1 \cdot 10^{-3} \cdot 24 = 4,471 \text{ fF}$$

$$R_{N,INV} = \frac{R_{N,RIF,S=1}}{S_{N,INV}} = 797,25 \Omega \quad R_{P,INV} = \frac{R_{P,RIF,S=1}}{S_{P,INV}} = 797,25 \Omega$$


 $\frac{1}{S_{PU}} = \frac{2}{S_P} + \frac{1}{2S_P} = \frac{4+1}{2S_P}$
 $S_{PU} = \frac{2}{5} S_P = \frac{2}{5} \cdot 21 = 8,4$

$$R_{PU} = \frac{R_{P,RIF,S=1}}{S_{PU}} = 2277,85 \Omega$$

$$t_{rx,90\%} = \Sigma_{IN,X} \ln(10) = [2277,85 \cdot 31,177 \cdot 10^{-15} + 797,25 \cdot 6,706 \cdot 10^{-15} + 797,25 \cdot 4,471 \cdot 10^{-15}] \cdot \ln(10) = 184,036 \text{ ps}$$

$$t_{ry,90\%} = \Sigma_{IN,Y} \ln(10) = [2277,85 \cdot 31,177 \cdot 10^{-15} + 250 \cdot 14,471 \cdot 10^{-15}] \cdot \ln(10) = 171,848 \text{ ps}$$